



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

H1420

对应国外型号
S1420

主要用途

一般用途和低噪音放大。

极限值 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

T_{stg} ——贮存温度	-55~150
T_j ——结温	150
P_C ——集电极耗散功率	625mW
V_{CBO} ——集电极—基极电压	60V
V_{CEO} ——集电极—发射极电压	60V
V_{EBO} ——发射极—基极电压	7V
I_C ——集电极电流	200mA
I_B ——基极电流	200mA

外形图及引脚排列

TO-92



1—发射极, E
2—基极, B
3—集电极, C

电参数 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	60			V	$I_C=1\text{mA}$, $I_B=0$
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			50	nA	$V_{CB}=40\text{V}$, $I_E=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			100	nA	$V_{EB}=6\text{V}$, $I_C=0$
$H_{FE}(1)$	直流电流增益	70		700		$V_{CE}=5\text{V}$, $I_C=2\text{mA}$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和电压			0.22	V	$I_C=50\text{mA}$, $I_B=10\text{mA}$
V_{BE}	基极—发射极电压		0.65		V	$V_{CE}=5\text{V}$, $I_C=2\text{mA}$
f_T	特征频率	150	400		MHz	$V_{CE}=5\text{V}$, $I_C=10\text{mA}$
C_{ob}	共基极输出电容			3.5	pF	$V_{CB}=10\text{V}$, $I_E=0$, $f=1\text{MHz}$